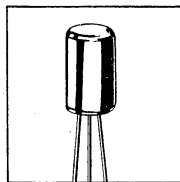


2SB185

ゲルマニウム・PNP・合金接合型
AF 小信号増幅用



☆AF 小信号一般増幅用で AF アンプ・ドライバ用に最適です。

★Germanium PNP alloy junction transistor.
★For universal small signal amplifier.

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a=25^{\circ}\text{C}$

項 目	記 号	2SB185	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-25	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-12	V
コレクタ電流	I_C	-150	mA
コレクタ損失	P_C	200	mW
接合部温度	T_j	85	$^{\circ}\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+85	$^{\circ}\text{C}$

電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a=25^{\circ}\text{C}$

項 目	記 号	条 件	min.	typ.	max.	単 位
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-20\text{V}, I_E=0$			-15	μA
エミッタ遮断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=-6\text{V}, I_C=0$			-12	μA
小信号電流増幅率	h_{fe}	$V_{CE}=-6\text{V}, I_C=-1\text{mA}, f=1\text{kHz}$		45		
遮断周波数	$f_{\alpha b}$	$V_{CB}=-6\text{V}, I_C=-1\text{mA}$		1		MHz
雑音指数	NF	$V_{CE}=-6\text{V}, I_C=-1\text{mA}, f=1\text{kHz}$ $R_g=500\Omega$, 帯域幅=100Hz		10		dB
電力利得	PG	$V_{CE}=-6\text{V}, I_C=-1\text{mA}, f=1\text{kHz}$ $R_g=2\text{k}\Omega, R_L=5\text{k}\Omega$	33		38	dB

- これより電力利得の小さいものは 2SB188 ㊦ P 161
大きいものは 2SB186 ㊦ P 149

